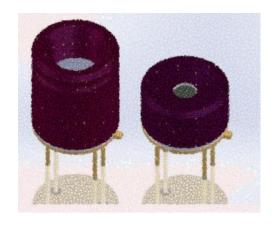
MLX90640ESF_BAA/BAB

32*24 点阵红外温度传感器 数据手册

1. 特性和优点

- 小尺寸,低功耗,32*24 像素红外 出厂校准 阵列
- 方便集成
- 标准的 T039 封装

- 噪声等效温差 (NETD) 0.1K RMS@1Hz 谏率
- I2C 兼容数字接口
- 可编程刷新速率 0.5Hz~60Hz
- 供电电压 3.3V
- 电流消耗: <23mA
- 两种视场角可选: 55°*30°和 110° *75°
- 工作温度: -45~85℃
- 测温范围: -40~300℃
- 符合 RoHS 标准



2. 应用实例

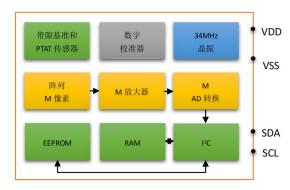
高精度非接触温度测量

- 安防、入侵检测
- 人体检测
- 智能楼宇环境温度测控
- 汽车空调控制
- 微波炉、烤箱温度检测与控制
- 工业零件温度监测
- 可视化温度传感器

驱动程序可从下面网页下载: https://github.com/melexis/mlx90 640-library

概述 3.

MLX90640 是工业标准并经过完全校准的 32*24 像素热红外阵列传感器,采用 4 脚 T039 封装以及 IIC 兼容的数字接口。 MLX90640 包含 768 个热红外像素点。内嵌 自身环境温度传感器和 VDD 电压检测 ADC。通过 IIC 接口,可以访问存储于内部 RAM 中的红外阵列、环境温度以及 VDD 实时 数据。



图表 1 功能组成框图

目录

MLX90640 数据手册中文版 英菲红外 15889623881

1.	特性和优点	. 1
2.	应用实例	. 2
3.	概述	2
4.	订购信息	. 4
5.	术语、缩写说明	. 5
6.	管脚定义	. 6
7.	绝对最大值范围	. 6
8.	一般电气特性	. 7
9.	异常像素修正	. 8
10.	详细说明	. 8
	10.1. 像素位置(坐标)	8
	10.2. 通讯协议	9
	10.3. 测量模式	11
	10.4. 更新速率(刷新速率)	11
	10.5.测量流程	12
	10.6. 测量刷新与读取	13
	10.7.地址映射(分布)	14
11.	计算对象温度	20
	11.1. 从 EERPOM 计算校准参数	
12.	性能测试图表	21
	12.1. 精度	21
	12.2 启动时间	23
	12.3. 噪声性能和分辨率	24
	12.4. 视场 (FOV)	27
13.	应用信息	28
	13.1. 电路设计注意事项	28
	13.2. 工作于"图像模式"	29
14.	使用建议	30
15.	机械尺寸	31
	15.1. FOV 55°	31
	15.2. FOV 110°	32
	15.3. 标记序列号	33
16.	标准信息	34
17	静由防护	34

4. 订购信息

产品	温度	封装	选型码	定制码	封装形式	说明
MLX90640	Е	SF	BAA	000	TU	32*24 红外阵列
MLX90640	Е	SF	BAB	000	TU	32*24 红外阵列

举例:

E: -40~85℃
SF: T039 封装
xAx:禁用 TGC 功能,并且不可更改
xxA: 视场角 110°*75°
xxB: 视场角 55°*35°
000: 无定制的标准产品
TU: 管状
MLX90640ESF-BAA-000-TU

表格 1 订购信息

5. 术语、缩写说明

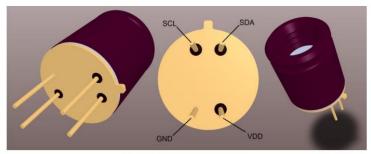
TC	温度校正系数,单位 ppm/℃
POR	上电复位
IR	红外线
Ta	环境温度(封装外皮温度)
IR data	红外数据(与接收到的红外光能量呈正比的原始 AD 数据)
ADC	模拟数字转换器
TGC	温度梯度系数
FOV	视场域(角)
nF0V	第 n 个像素的视场角
I2C	一种数字总线标准
SDA	I ² C 总线的数据线
SCL	I ² C 总线的时钟线
LSB	低位在前(按位传输数据时)
MSB	高位在前(按位传输数据时)
Fps	帧每秒(描述数据的传输速率)
MD	主驱动器(主设备)
SD	从设备
ASP	模拟信号处理
DSP	数字信号处理
ESD	静电放电
EMC	电磁兼容
CP	补偿像素
NC	未连接
NA	不适用
TBD	待定,不确定
TO	像素温度值,测量到的物体温度

表格 2 术语、缩写说明

6. 管脚定义

管脚号	管脚名称	功能说明
1	SDA	I ² C 串行接口数据线 (输入/输出)
2	VDD	电源正
3	GND	电源负 (GND)
4	SCL	I ² C 串行接口时钟线(输入)

表格 3 管脚定义



图表 2 MLX90640 外形及管脚定义

7. 绝对最大值范围

参数	符号	最小值	标准值	最大值	单位	备注
电源 (超压)	v			5	V	
电源 (工作)	Vno			3. 6	V	
负压 (所有引脚)				-0.3	V	
操作温度	Тамв	-40		85	°C	
存储温度	Tst	-40		125	°C	
静电 (AEC Q100 002)		4			kV	
SDA 灌电流				40	mA	

表格 4 绝对最大值范围

注:超过绝对最大额定值可能造成永久性损害。长时间工作在绝对最大额定条件下可能会影 响设备的可靠性。

8. 一般电气特性

参数	符号	最小值	标准值	最大值	单位	备注
供电电压	V _m	3	3. 3	3.6	V	
电流消耗	Ino	15	20	25	mA	
上电复位启动电压	V _{POR_UP}	2. 2		2.6	V	VDD 上升沿
上电复位关机电压	V POR_DOWN			2. 55	V	VDD下降沿
上电复位迟滞	V _{POR_HYS}		50		mV	
I2C 地址		0x01	0x33	0xFF		
输入高电平	V _{TH}	0. 7*Vm			V	
SDA、SCL	V IH	U. TAVDD			, v	
输入低电平	V _{10W}			0. 3*Vnn	V	
SDA、SCL	V LOW			O. Sav DD	V	
输出低电压 SDA	VaL			0.4	V	
漏电流	I SDA_LEAK			±10	uA	SDA
/啊 PES VIL	I SCL_LEAK			±10	uA	SCL
电容特性	C _{SDA}			10	pF	SDA
日本 4年	Cscl			10	pF	SCL
应答装载时间	T _{SUAC(MD)}			0.45	uS	
应答保持时间	T _{DUAC(MD)}			0. 45	uS	
应答装载时间	TSUAC(SD)			0.45	uS	
应答保持时间	T _{DUAC(SD)}			0.45	uS	
I2C 时钟频率	F _{12C}		0.4	1	MHz	
EEPROM 擦/写周期				10		
EEPROM 写操作耗时	TWRITE	5			mS	

表格 5 电气特性

注: 为了获得最佳性能,建议将电源电压尽可能准确稳定地保持在 3.3V±0.1V。

注 2: 当要修改 EEPROM 中的数据时,必须先执行擦除操作(写 0x0000)。每次写完后至少需 要5毫秒的延迟。

注3: 从设备地址必须为1~127(0地址不可使用)。

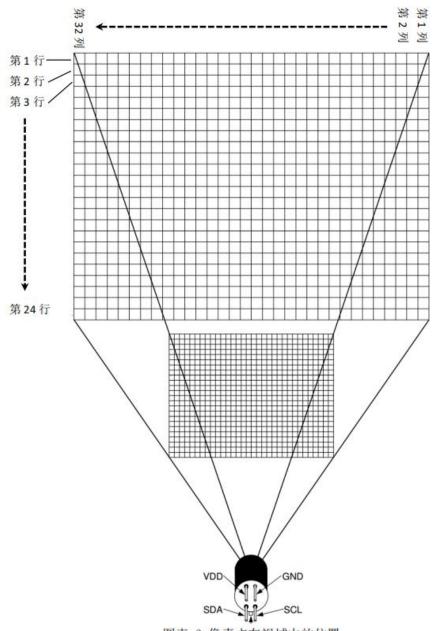
9. 异常像素修正

因为生产工艺原因,MLX90640 的 768 点阵中会存在不能使用或者精度未能达到要求的像素 点(最多 4 个像素),错误(异常)的像素数据表现为 0 或者明显超出温度范围。这些不 能使用的像素信息保存于 EEPROM 中,可以通过 IIC 接口读出这些异常像素点并加以校正, 校正方法可以使用相邻正确像素的平均值的方法。

10. 详细说明

10.1. 像素位置(坐标)

数据阵列由 768 个红外传感器测构成(每个传感器也称作"像素")。每个像素用它所处 的行和列来表示 PIX(i,j), i 表示行(1^{2} 24), j 表示列(1^{3} 2)。



图表 3 像素点在视域中的位置

10.2. 通讯协议

该设备采用 IIC 协议,支持快速模式(FM+)(最高 1MHz 时钟频率),只可作为从机在 总线上使用。

SDA和 SCL端口5V兼容,可以直接连接到5V逻辑的IIC总线网络。

从地址可编程的,可以有多达127个不同的从地址。

10.2.1. Low level

10.2.1.1. 开始和停止条件

MLX90640 数据手册中文版

英菲红外 15889623881

每次通讯均以 START 条件发起,并以 STOP 条件结束。START 条件是指 SDA 由高到低跳变, 而 STOP 条件是指 SDA 由低到高跳变,这两种信号都必须在 SCL 高电平时执行。

10.2.1.2. 设备寻址

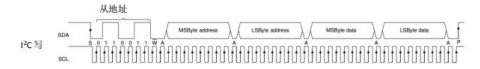
寻址动作由主设备发起,主设备在开始信号(START 信号)完成后发送 7 位从设备地址码和 1 位读写标识码。读写位表示数据的传输方向。

读(高电平):主设备将从从设备读取数据

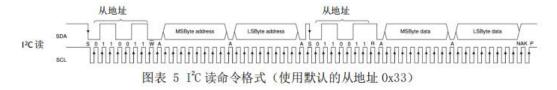
写(低电平):主设备将向从设备发送数据

10.2.1.3. 应答

主设备发送完 8 位的从机地址后,在第 9 个时钟周期释放 SDA 总线,若从机拉低 SDA 表示应答信号(ACK),否则表示非应答信号(NoACK)。



图表 4 I2C 写命令格式 (使用默认的从地址 0x33)



10.3. 测量模式

在此模式下,MLX90640 不断的更新红外阵列数据和环境温度数据到内部的 RAM 区,更 新速率取决于帧速率寄存器()的值,亦即:每1秒进行一次更新。在此模式下,外接的 上位机(MCU)对所有寄存器和存储器具有完全的访问权(可读写任意寄存器和 RAM、EEPROM)。

10.4. 更新速率(刷新速率)

更新速率由"控制寄存器 1"(0x800D)控制。例如:设置此寄存器=011B,则更新速率 为 4Hz, 也就是每 250ms 更新一次 RAM。

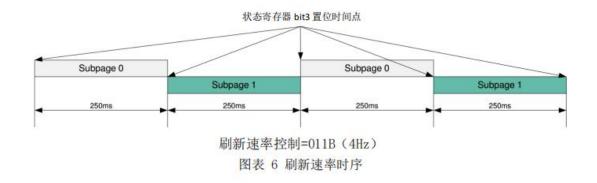
注:可直接修改寄存器的值来实现刷新速率的修改,另外还可以将所需的刷新率编程到 EEPROM 中,从而消除避免每次开机时重新配置的过程。刷新速率对应的 EEPROM 单元地址 是

0x240C(见表 8)。

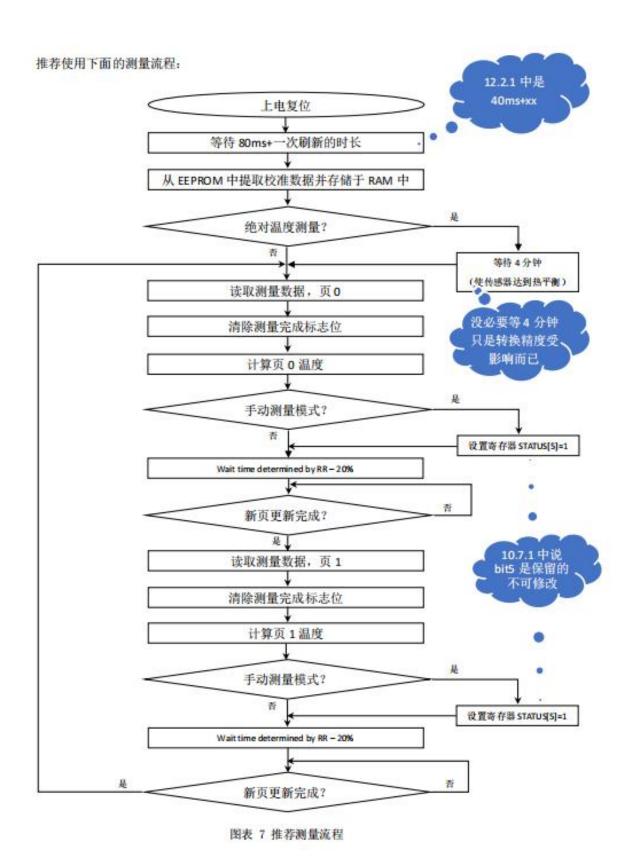
被更新的 RAM 有多个页,最新被更新的子页在"最后测量子页"域中显示。

如果要计算环境温度(Ta)则必须同时读取两个 RAM 子页,因为环境温度的计算需要两 个子页的数据合并以后方可获得,即:环境温度的转换速率会比"控制寄存器 1"设置的速 率慢一半。

当新的一个子而数据更新完成后,"状态寄存器"(0x8000)的 bit3 自动置 1,此位需要 用户在读取子页后置 0。



10.5.测量流程



12

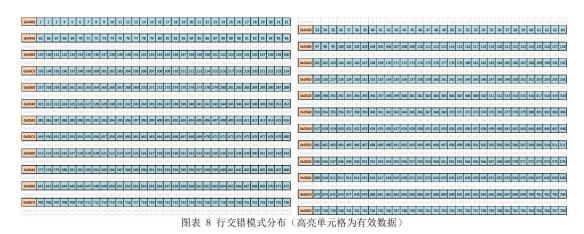
10.6. 测量刷新与读取

测量完成的红外阵列数据更新到 RAM 区,占用 1536 字节,MLX90640 每次测量一半像素 点,分两次完成所有768像素的测量,在逻辑上将每次测量完成的一半称为一个子页,故 此 数据帧有两个子页面(两个子页合并以后才是完整的 768 个像素数据),每次完成一半 像素 点的分布模式有两种,可通过控制寄存器 1(0x800D)的 bit12 位来设置。

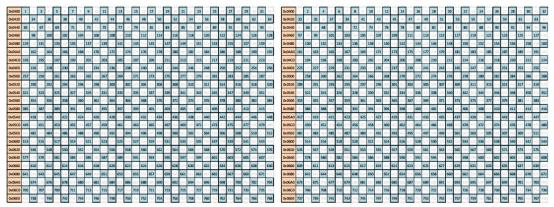
- (1) 棋盘模式(默认), (每个像素间隔排列-像素交错模式)
- (2) 电视交错模式, (隔行排列-行交错模式)

注 1:标准的 MLX90640 是在棋盘模式下校准的,因此传感器在棋盘模式下具有更好的噪声 滤除性能。为了得到最好的结果,建议使用默认的棋盘模式。

注意 2: 请确认子页面寄存器的配置。详见: 表 6 子页面控件的优先级。



图表 8 行交错模式分布(高亮单元格为有效数据)



图表 9 像素交错模式分布 (高亮单元格为有效数据)

10.7.地址映射(分布)

0x0000	DOM
0x03FF	ROM
0x0400	BUV
0x07FF	RAM
0x2400	PERFORM
0x273F	EEPROM
0x8000	寄存器
0x800C	(MLX 保留)
0x800D	ille de las
0x8010	寄存器
0x8011	寄存器
0x8016	(MLX 保留)

图表 10 MLX90640 存储器地址分布

10.7.1. 内部寄存器

有一些内部寄存器可供用户访问,通过这些寄存器可以对 MLX90640 进行配置: 状态寄存器 STATUS (0x8000)

位	符号	值	描述	默认值
Bit15:5			保留	
Bit4			RAM 中的数据是否可写 0: 不可写; 1: 可写	
Bit3			子页更新完成标志位 1: 更新完成,此位必须用户写 0 清除	
Bit2:0			子页面测量控制 000: 测量子页面 0 001: 测量子页面 1 010~111: 保留	

图表 11 状态寄存器 (0x8000) 定义说明

控制寄存器 1CTR1 (0x800D)

位	符号	值	描述	默认值
Bit15:13			保留	
Bit12			像素分布模式 0: 行交替模式 (TV 模式)	

	1: 像素间隔模式 (棋盘模式), 默认	
	采样分辨率设置	
	00: 16 位	
Bit11:10	01: 17 位	
	10: 18位(默认)	
	11: 19位	
	刷新速率控制	
	000: 0.5Hz	
	001: 1Hz	
	010: 2Hz	
Bit9:7	011: 4Hz	
	100: 8Hz	
	101: 16Hz	
	110: 32Hz	
	111: 64Hz	
	指定要更新的子页	
Bit6:4	000: 子页 0	
	001: 子页 1	
	010~111: 未定义	
27/200	子页切换控制(仅当子页模式=1时有效)	
Bit3	0: 自动切换子页 0 和子页 1 (默认)	
	1: 指定子页号	
_	RAM更新控制	
Bit2	0: 测量完成后自动更新到 RAM (默认)	
	1: 仅当状态寄存器中的 RAM 可写=1 时才将测量	
	结果更新到RAM	
Bit1	保留	0
	使能子页模式	
Bit0	0: 禁用子页模式,所有数据更新在一页里	
	1: 使能子页模式 (页 0 和页 1), 默认	

图表 12 控制寄存器 1 (0x800D) 定义说明

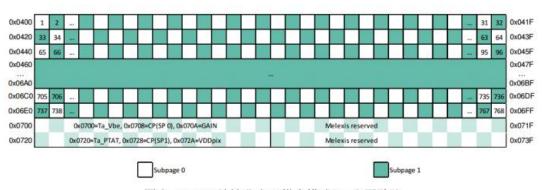
使能子页模式 CTR1[bit0]	使能子页指定 CTR1[bit3]	指定子页 CTR1[bit6:4]	工作模式
0	0	-	仅测量子页 0
0	1	-	仅测量子页 0
1	0	-	子页 0 和 1 自动交替
1	1	0	仅测量子页 0
1	1	1	仅测量子页 1

表格 6 子页刷新优先级控制

位	符号	值	描述	默认值
Bit15:4			保留	
Bit3			保留,总是0	
Bit2			SDA 驱动电流控制 0: 电流限制功能打开(默认) 1: 电流限制功能关闭	
Bit1			高低电平参考电压设置 0: VDD (默认) 1: 1.8V	
Bit0			禁用 FM+模式(快速模式) 0: 不禁用,即:使用 FM+模式(默认) 1: 禁用 FM+模式	

图表 13 I²C 配置寄存器 I2CCFG (0x800F) 定义说明

10.7.2. RAM



图表 14 RAM 地址分布(棋盘模式)-出厂默认



图表 15 RAM 地址分布 (行交错模式)

10.7.3. **EEPROM**

EEPROM 中存储的是 MLX90640 的校准参数和上电后自动加载的寄存器值。

EEPROM 地址	访问权限	含义说明
0x2400		
0x2401		保留
0x2402		
0x2403		上电后加载到配置寄存器
0x2404		
0x2405	MT V	保留
0x2406	MLX	
0x2407		唯一识别码 ID1
0x2408		唯一识别码 ID2
0x2409		唯一识别码 ID3
0x240A		设备选项
0x240B		保留
0x240C		上电后加载到控制寄存器1
0x240D	用户	上电后加载到控制寄存器 2
0x240E	HIT	上电后加载到 I ² C 配置寄存器
0x240F		高字节保留 低字节 I ² C 地址

表格 7 EEPROM 中的配置参数地址定义

上电复位后,MLX90640 从 EEPROM 读取参数,并将对应参数加载到配置寄存器和控制寄 存器。通过这种方式完成测量前的自动配置工作。EEPROM 中一些地址与寄存器的对应关系 如下表所示(寄存器的具体定义说明请参阅 10.7.1 小节)。

EEPROM 地址	寄存器地址	访问权限	寄存器名称	数值
0x240C	0x800D	用户	控制寄存器 1	0x1901
0x240D	0x800E	用户	控制寄存器 2	0x0000
0x240E	0x800F	用户	I ² C 配置寄存器	0x0000
0x240F	0x8010	用户	高字节保留 低字节 I ² C 地址	0xBE33

表格 8 EEPROM 地址与寄存器地址映射关系

MLX90640 数据手册中文版 英華紅外 15889623881

地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0X2400	Osc Trim	Ana Trim	MLX	CFG	MLX	MLX	MLX	IDI	ID2	ID3	MLX	MLX	CTR1	CTR2	I*CCFG	Addr
0X2410	300	osávg	OCC row	01…24	(6*4*3h	oit+sig	n)	ı	OCC co	1 01	32 (8*4*	k3bi t+s	sign)			
0X2420	ACC	aAVG	ACC row	0124	(6*4*3b	oit+sig	n)		ACC co	1 01	32 (8*4*	k3bit+s	si gn)			
0X2430	GAIN	PTAT25	KvKtPTAT	KvVDD25	KvAvg	MLX		KtaAva	Kv, Kta Sca	ACP 1, 2	0ff-CP1, 2	Kv, Kta Cp	Ks Ta, TGC	Ks To 4, 3	Ks To 2, 1	CT 4, 3
0X2440 0X2450 0X2460 0X2470 0X2480 0X2490 0X24A0 0X24C0 0X24C0 0X24E0 0X2510 0X2510 0X2520						768 组体	扇移值、	α, Κι	ta、异常	常值(参	(1	1	1	1	

表格 9 EEPROM 地址分布框图

Address \ bit	15 14 13 12 (Alpha PTAT - 8)*4	11 10 scale 0	9 8	7 6 scale 0	5 4	3 2 1 scale Occ rem	0		
0x2410	(Adria Livi - o) 4	scare_s			AU_00	scae_occ_jeni	24"		
0x2411 0x2412	± OCC row 4	T +000	2 PIX_OS	average ± OCC	anu 9	± OCC row 1			
0x2412	± OCC row 8		now 7	± 000		± OCC row 5			
0x2414	± OCC row 12	± 000	2.5300	± 000		± OCC row 9			
0x2414 0x2415	± OCC row 16	± 000		± 000		± OCC row 13			
0x2415	± OCC row 20	± 000		± 000	± OCC row 17				
0x2416	± OCC row 24	± 000		± 000	± 000 row 21				
0x2417 0x2418	± OCC column 4		column 3	± 000 c		± OCC column 1	e e		
0x2418	± OCC column 8		column 7	± 000 c		± OCC column 5			
0x241A	± OCC column 12		olumn 11	± 000 o		± OCC column 9			
0x241A	± OCC column 16		olumn 15	± 000 o		± OCC column 13			
0x241C	± OCC column 20		olumn 19	± 000 o		± OCC column 1			
0x241D	± OCC column 24		olumn 23	± 000 o		± OCC column 2:			
0x241D 0x241E	± OCC column 28		olumn 27	± 000 o		± OCC column 25			
0x241F	± OCC column 32	± 000 c		± 000 o		± OCC column 2			
0x2420	Alpha scale - 30		ACC row	Scale AC		Scale ACC remna			
0x2421	1.900.000			rity_average	-2000				
0x2421	± ACC row 4	+ 400	row 3	± ACC	mw 2	± ACC row 1			
0x2423	± ACC row 8	± ACC		± ACC		± ACC row 5			
0x2424	± ACC row 12	170.00	row 11	± ACC	25111.5	± ACC row 9			
0x2425	± ACC row 16		row 15	± ACC		± ACC row 13			
0x2426	± ACC row 20		row 19			± ACC row 17			
0x2427	± ACC row 24		row 23	± ACC row 18 ± ACC row 22		± ACC row 21			
0x2428	± ACC column 4	± ACC column 3		± ACC column 2		± ACC column 1			
0x2429	± ACC column 8	± ACC column 7		± ACC column 6		± ACC column 5			
0x242A	± ACC column 12	± ACC column 11		± ACC column 10		± ACC column 9			
0x2428	± ACC column 16	± ACC column 15		± ACC column 14		± ACC column 13			
0x242C	± ACC column 20	± ACC column 19		± ACC column 18		± ACC column 17			
0x242D	± ACC column 24	± ACC column 23		± ACC column 22		± ACC column 21			
0x2426	± ACC column 28	± ACC column 27		± ACC column 26		± ACC column 25			
0x242F	± ACC column 32	± ACC column 31		± ACC column 30		± ACC column 29			
0x242F	I NOO ONG III OL	2 NOO 0		AIN	Pignish GO	2.7500 6000731 61	,		
0x2431				AT 25					
0x2432	± Kv_PTAT		2711	11_23	±Kt_PTAT				
0x2433		r_Vdd				dd_25			
0x2434	± Kv_avg_RowOdd-ColumnOdd		ven-ColumnOdd						
0x2435	±IL CHESS C3 - 5 bits	INV SVE NOWE	±IL CHESS C2-			±L CHESS C1-6 bits			
0x2436		Odd-ColumnOdd	IIL CHESS CZ*	± Kta_avg_RowEven-ColumnOdd					
0x2437		Odd-ColumnEven	170	± Kta_avg_RowEven-ColumnCodd					
0x2438	MLX Res control calib		cale	Kta scale 1 Kta scale 2					
0x2439	± Alpha (CP subpage_1/ CP subpa		care	htd_st	Alpha CP subpage_0				
0x243A	± Offset (CP subpage_1 - CP su				± Offset CP subpage				
0x243A		v CP				ta CP			
0x2436		a*2^13				±4)*2^7			
0x243D		2 (0°CCT1°C)				nge 1 (<0°C)			
0x243E		ge 4 (CT2°C)				3 (CT1°CCT2°C)			
0x243E	MLX temp step x 10		T4						
0x243P	± Offset pixel (1, 1)	The state of the s		α pixel (1, 1)		KsTo Scale offset - 8 ± Kta (1, 1) Ou			
0x2440 0x2441	± Offset pixel (1, 1)			a pixel (1, 2)		± Kta (1, 2)	Outlie		
UK2441	± Uniset pixel (1, 2)			a pixei (1, 2)		I KUI (1, 2)	Cutlie		
0x245E	± Offset pixel (1, 31)			α pixel (1, 31)		± Kta (1, 31)	Outlie		
	± Offset pixel (1, 31) ± Offset pixel (1, 32)					± Kta (1, 31) ± Kta (1, 32)	Outlie		
DU TAKE			A	a pixel (1, 32)			Outlie		
0x245F									
0x2460	± Offset pixel (2, 1)			a pixel (2, 2)		+ Vto (2, 2)	Charles .		
	± Offset pixel (2, 1) ± Offset pixel (2, 2)			a pixel (2, 2)		± Kta (2, 2)	Outlie		
0x2460				α pixel (2, 2) — α pixel (24, 31)		± Kta (2, 2) ± Kta (24, 31)	Outlie		

表格 10 按位说明的校正参数

注 1: EEPROM 中的地址 $0x2440^{\sim}0x273F$ 内包含了每个像素的校准信息(出厂时已完成校准),

可能不等于 0x0000。当任意某个像素数据等于 0x0000 时,基本可以认定这个像素采样失败

(错误数据),此值不可用于计算温度。根据用户的实际应用需求,这些错误的像素数据值可以替换为默认值,如-273.15℃,当然也可以取环境温度代替,或者从相邻像素计算平均值。

注 2: EEPROM 中的地址 0x2440~0x273F 每个字的最低位表示某个像素在出厂校准时是否达到了校准规范要求,如果该位=1,则表示该像素至少有一个校准参数超出了校准规范,且该像素被认为是异常值,即:这个像素的值在测量过程中不可信(精度难以保障)。根据不同的应用需求,可以选择用相邻像素表示的平均温度来代替该像素的测量结果。

注 3:每个 MLX90640 传感器中最多可能存在 4 个不能用的像素(请检查 EEPROM 标志位,前

在使用过程中人为校正这些像素的数值)。

11. 计算对象温度

11.1. 从 EERPOM 计算校准参数

注: EEPROM 中的所有数据均为二进制补码形式(另有说明时除外) 注:下面文字中,用 EE[0xxxx]表示 EEPROM 中某个地址的数值,每个值占用 2 字节。 在本例中,我们将恢复像素(12,16)的校准数据

11.1.1. 恢复 VDD 传感器参数

下面的公式用于计算 MLX90640 的 VDD:

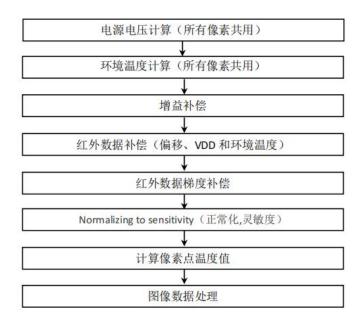
Kvdd=EE[0x2433]的高字节*32 K_{Vdd} =(signed short)((EE[0x2433]&0xFF00)>>8)*32

 $VDD_{25} = EE[0x2433] \& 0x00FF$ $VDD_{25} = (VDD_{25} - 256) \times 2^5 - 2^{13}$

11.1.2. 恢复环境温度传感器参数

一堆乱乱的公式,而且丝毫没有解释说明,把取某些位的方法非要搞成公式,还有就是 有符号数(signed)用"如果···那么···"的文字来描述,把简单的事搞得好像很复杂的样子。 瞎卖弄啥, 也卖弄不清楚, 脑袋有问题。

对于神一样的没有任何解释说明的算式,MLX 提供的驱动程序包里已经包含了这部分, 所以就不在这里浪费时间了(确实没有意义)。



12. 性能测试图表

12.1. 精度

所有精度指标仅适用于固定的等温条件。

此外,只有当目标完全填满传感器的 FOV (视场)时,精度才有效。

参数定义:

帧精度:数据帧或帧中所有(768)像素的平均值,第 n 帧数据的精度可以使用下式计算:

$$\overline{T_{0_}frame(n)} = \frac{1}{768} \sum_{m=1}^{768} T_{0}(m, n)$$

帧精度 =
$$\overline{T_{0} frame(n)}$$
 - 实际温度 T_{target}

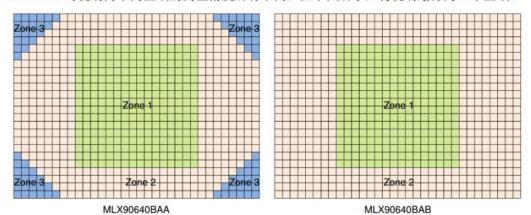
非均匀性:也称"不一致性",是指每个像素相对于平均值的最大偏差。

不一致性 =
$$MAX(|T_0(m) - \overline{T_0 frame(n)}|)$$

像素温度的绝对精度为:

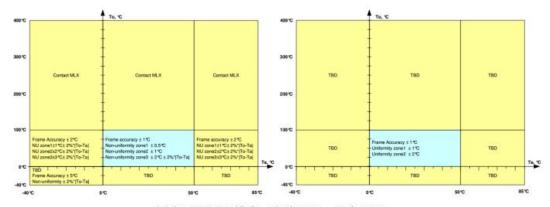
绝对精度
$$T_0acc(n) = 帧精度 + 不一致性$$

MLX90640 对视场内不同区域的测温精度所有不同,如下图所示,将视场划分为3个区域。



图表 17 不同型号传感器的测温精度区域划分

每个区域内的测温精度指示如下图所示:



图表 18 测温精度 (左为 BAA, 右为 BAB)

MLX90640 数据手册中文版 英菲红外 15889623881

例:假设传感器(BAA 类型,区域 1)测量的是 80℃的目标,则温度结果的最大误差不会 超过:

绝对精度 = 帧精度 + 不一致性 = ±1 ± 0.5 = ±1.5℃

注: 为了获得最佳的性能, 电源电压应尽可能准确稳定的保持在 3.3V±0.1V。

12.2 启动时间

12.2.1. 第 1 组有效数据

上电启动后到第一组有效数据测量完成的时长 $T_{valid\ data}$ 与采集速率(刷新速率)参数 有关,可以使用下式计算:

$$T_{valid_data} = \left(40 + \frac{1000}{xHz}\right) ms$$

例:默认采集速率为 2Hz,则自上电后开始到首组个有效数据完成需要的时间为:

$$T_{valid_data} = \left(40 + \frac{1000}{xHz}\right) = (40 + 500) = 540ms$$

上电复位后, 总是先测量子页 0, 然后是子页 1。

注: 如果动态更改刷新速率 (通过将新值写入设备寄存器 (0x800D)),则仅在被测量 的子页面完成后才会生效。



12.2.2. 发热特性

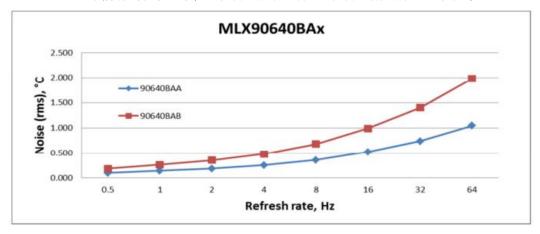
MLX90640 在启动后需要一定的时间达到热平衡, 热平衡后才具有相对稳定和高精度性 能,这一时间一般不超过4分钟。

12.3. 噪声性能和分辨率

配置寄存器(0x800D)中有两个位(bit11:10)可以更改 MLX90640 测量值的分辨率。 提高分辨率可以降低噪声,提高整体噪声性能。

噪声测量条件为: To=Ta=25℃

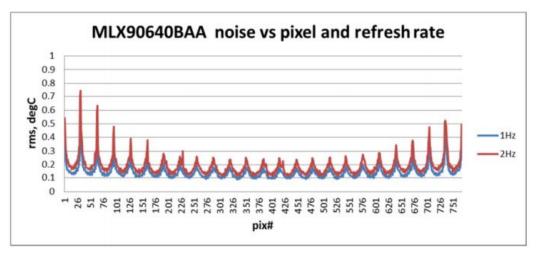
注:由于热红外辐射的性质,高温时噪声减小,低温时噪声增大属于正常现象。



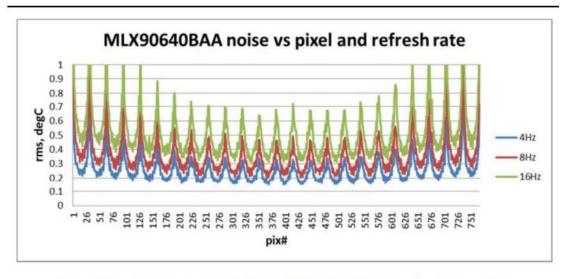
图表 19 噪声与刷新速率关系曲线

图表 19 噪声与刷新速率关系曲线

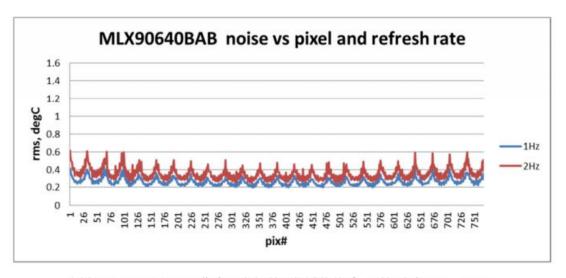
并非所有像素都具有相同的噪声性能。由于集成透镜的光学性能,通常情况下,与中 间的传感器相比, 帧角的像素噪声更大。下图显示了噪声性能随帧内像素位置(像素数)的 分布情况。



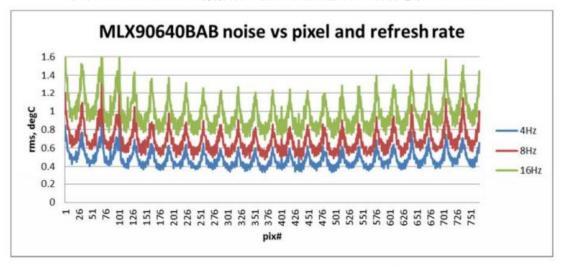
图表 20 MLX90640BAA 像素噪声与所处位置的关系(刷新速率 1Hz、2Hz)



图表 21 MLX90640BAA 像素噪声与所处位置的关系 (刷新速率 4Hz、8Hz、16Hz)



图表 22 MLX90640BAB 像素噪声与所处位置的关系 (刷新速率 1Hz、2Hz)



图表 23 MLX90640BAB 像素噪声与所处位置的关系(刷新速率 4Hz、8Hz、16Hz)

MLX90640 数据手册中文版 英菲红外 15889623881

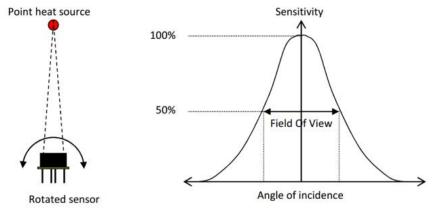
NETD (K)	1Hz 噪声有效值	(RMS),温度相同,所	有像素
MLX90640	平均值	最小值	标准差
BAA	0.14	0. 1	0. 05
BAB	0.25	0. 2	0.05

表格 11 噪声特性

12.4. 视场 (FOV)

图表 24 视场测量

视场是以较宽方向计算的,本实例中是指 32 像素的方向。



图表 24 视场测量

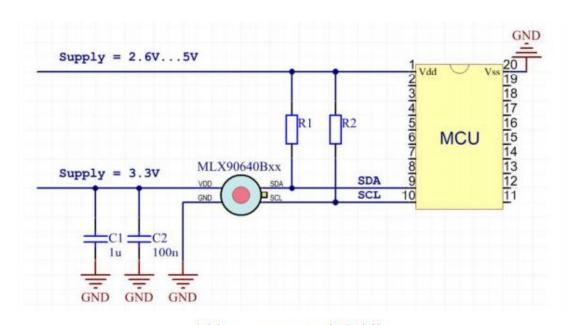
视场是以较宽方向计算的,本实例中是指32像素的方向。

视场	X 方向	Y方向	中心点指向 (X和Y方向)		
	标准	标准	最大		
MLX90640-ESF-BAA	110°	75°	5°		
MLX90640-ESF-BAB	55°	35°	3°		

表格 12 可选视场

13. 应用信息

13.1. 电路设计注意事项



图表 25 MLX90640 电路连接

图表 25 MLX90640 电路连接

MLX90640 使用完全兼容 IIC的数字接口,可以与具备此接口的 MCU 等连接通讯, MCU 要 能提供 $2.6V^{\sim}5.0V$ 的通讯电源(强上拉), 传感器使用 3.3V 供电。 建议 R1 和 R2 取 $2k\Omega$ 。

MLX60640 的供电必须 3.3V, 与之连接的单片机可以 2.6~5.0V 供电, 即: 对于 MLX90640 传感器, 供电必须 3.3V, 但 I2C 总线可以 2.6~5.0V (上拉), 么有问题的。

13.2. 工作于"图像模式"

在某些应用程序中,可能不需要计算温度,而仅需要有示意性的图像(例如在机器视觉 系统中),在这种情况下,不需要执行所有的计算,这样可以节省计算时间或允许使用性能 较弱的 CPU (单片机)。

为了得到红外热像,只需要以下计算流程: (仅是减少了温度计算步骤)



图表 26 热成像 (图像) 计算流程

14. 使用建议

光学输入端(传感器滤波镜片)的污损可能导致未知的光学信号滤波/失真,从而导致 不确定的误差产生。

红外传感器天生易受热梯度引起的误差影响。这种现象是有物理原因的,尽管 MLX90640Bxx 经过精心设计,但建议不要让 MLX90640Bxx 受热,特别是瞬态温度环境的影

MLX90640Bxx 仅可可用于非接触温度测量,特殊的非常规的使用方法会导致不可预知的 结果。

IIC上的电容负载会降低通信效率。

与电阻相比, 在上拉电路中使用电流源可能会有更优的效果, 进一步的改进是可以使用 专门的总线加速器。

对通讯接口的进一步优化改进是增大上拉电流(降低上拉电阻值)。 IIC 兼容模式的输入 IIC 规范具有更高的总体容错能力,但即使使用大功率 IIC 专用于上拉电流, 低电平

的输出能力也有局限性。另一个选择是降低通讯速率来保证通讯的正确性。

器件发热可能会以两种方式影响性能:一是"环境"敏感元件被加热到明显高于实际环 境温度的水平, 二是在外壳上产生温度梯度, 这将在本质上导致热梯度, 最终影响测温精度。 与大多数集成电路一样, MLX90640Bxx 也需要在电源处连接退耦电容。MLX90640Bxx 是 一种由传感器、模拟信号部分、数字部分和 1/0 电路组成的混合信号器件,为了保持低噪 声,

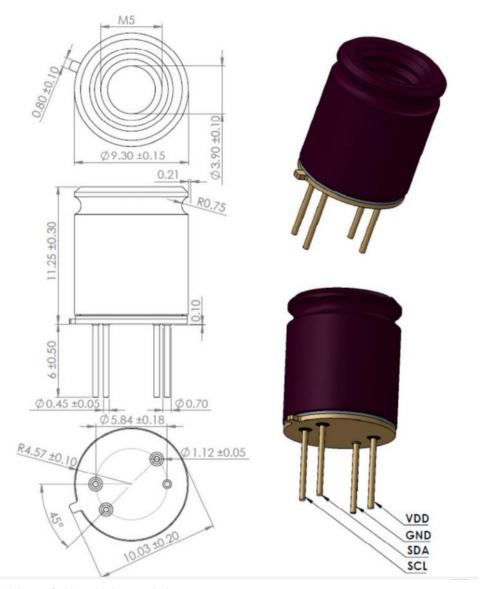
需要对电源开关噪声进行退耦。外部电路的高噪声也会影响器件的噪声性能。在许多应用中 一个 100nF+1 JF 陶瓷电容器就近与 VDD 和 Vss 连接是一个不错的做法。需要注意的是, 不仅

与 VDD 管脚的距离需要尽量短, 到 Vss 管脚的距离也需要尽量短。

查看 www.melexis.com 了解关于 MLX90640Bxx 的最新应用说明。

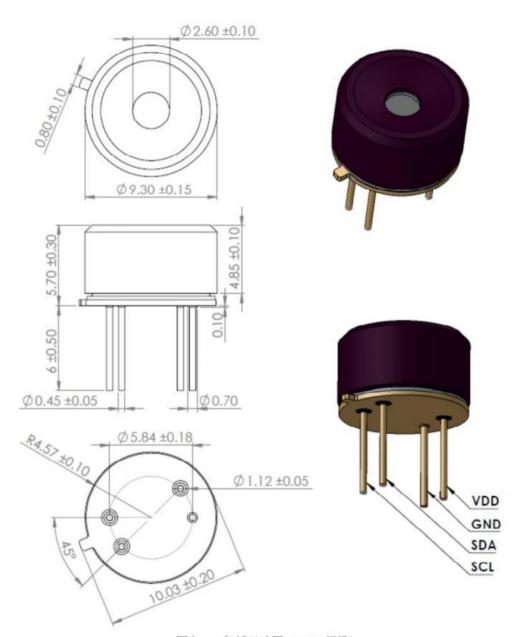
15. 机械尺寸

15.1. FOV 55°



图表 27 机械尺寸图 (55° 视场)

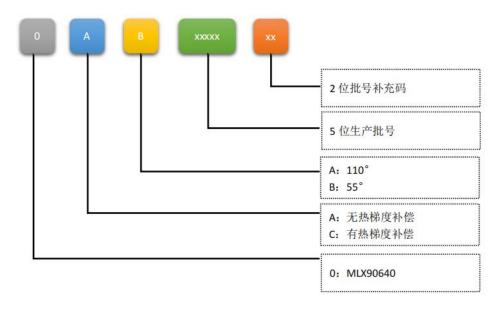
15.2. FOV 110°



图表 28 机械尺寸图 (110° 视场)

15.3. 标记序列号

MLX90640 外壳上有 10 个激光标记的序列码,说明如下:



例: "OAA1010218"表示型号为 MLX90640BAA, 生产批号为 10102, 批号补充码为 18, 无 热梯度补偿。

16. 标准信息

根据半导体行业的标准,我们的产品在焊接技术、可焊性和湿敏性方面都是合格的。 有关测试方法以及产品集成过程中选择的焊接方法的正确性验证需要参考更多细节, Melexis 建议在我们的网站上查阅焊接推荐一般指南。对于所有与上述文件中所述不同的焊 接技术(峰值温度、温度梯度、温度剖面等),必须与 Melexis 单独商定并做分类和可行性

试。

Melexis 通过推广无铅解决方案,为全球环境保护做出了贡献。有关符合 RoHS 的产品 的更多信息,请访问我们网站的页面:http://www.melexis.com/en/quality-environment

17. 静电防护

电子半导体产品对静电放电(ESD)很敏感。 在处理半导体产品时,一定要遵守静电放程序。